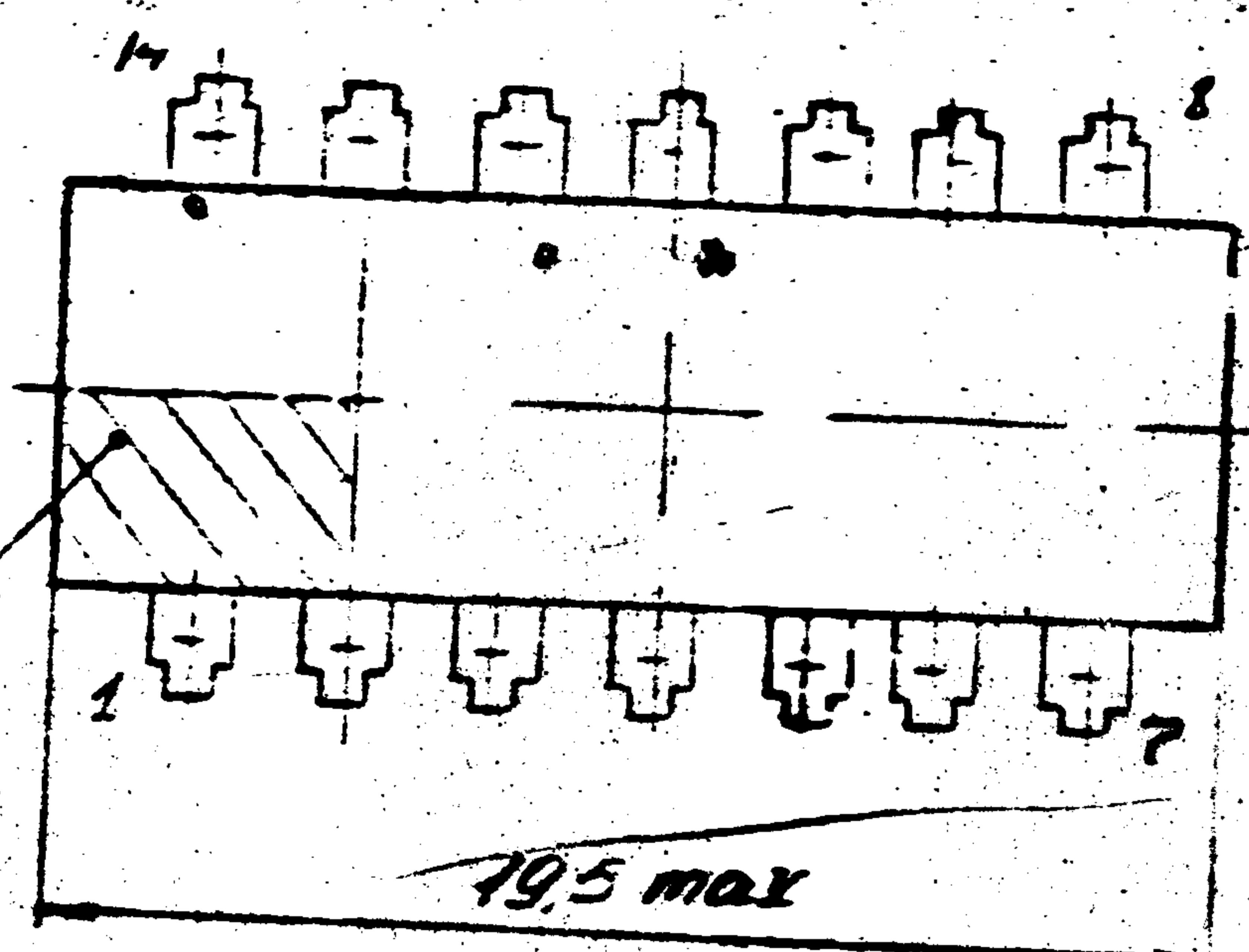
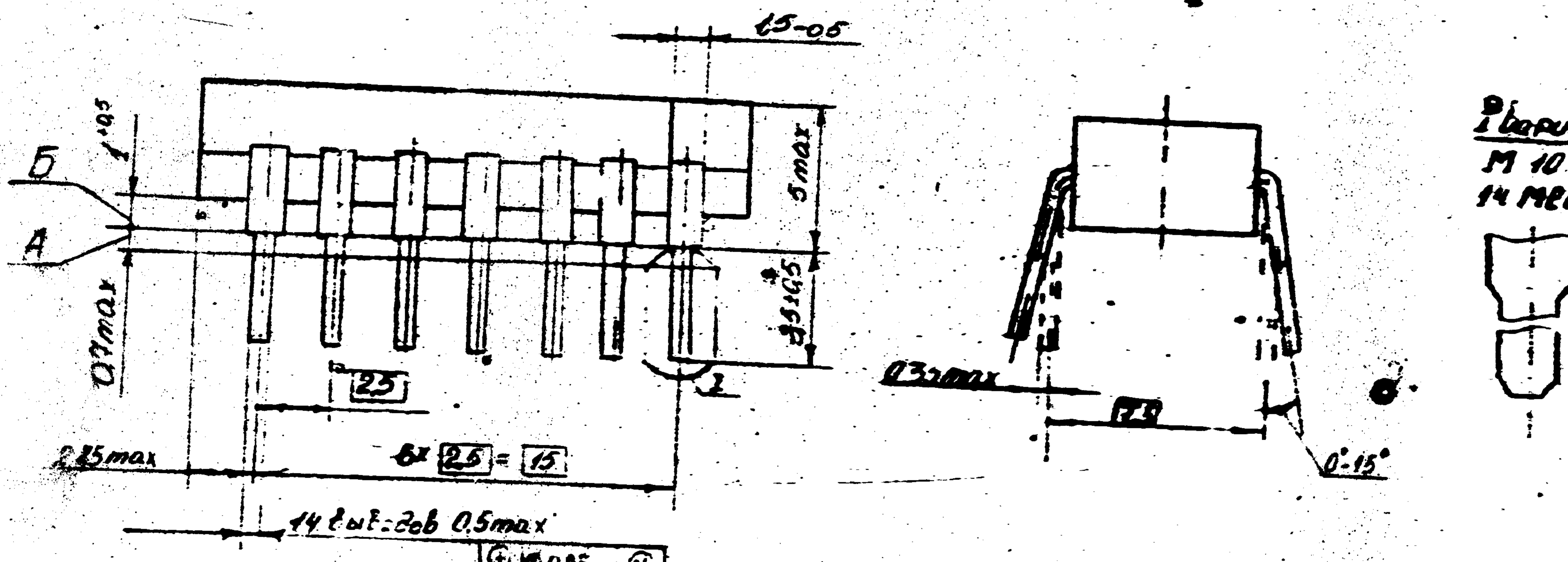


СОЛНЦЕ В. СССР

Микросхемы К172ИМ1, К172ИМ2, К172ИМ, К172ИИ, К172ТРИ

СТИКЕТКА  
І ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полупроводниковые интегральные микросхемы представляет собой:  
К172ИМ2 - Логический элемент 1ИЛИ-НЕ/1ИЛИ  
К172ИМ1 - Четыре логических элемента 2И  
К172ИМ - Два логических элемента 2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ  
К172ТРИ - Триггер двухступенчатый с входной логикой  
К172ИИ - Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ



1. А-зона вывода, в пределах которой установлено сопротивление изоляции в пределах 10<sup>12</sup> Ом на 500 В при отсутствии напряжения на выводе.
2. Б-длина вывода, обеспечивающая гарантированный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочное плоскость.
3. Нумерация выводов показана условно.
4. Размер 7,5 выполняется при установке ИС на печатную плату.
5. Форма выводов, ограниченная размером 1,5-0,5 не регламентируется.
6. Зона квича - место для выполнения знака квича.

Масса не более 1.1 г

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Обозначение вывода					Назначение вывода
K172ИМ1	K172ИМ2	K172ИМ	K172ИИ	K172ТРИ	
1	1	1	1	1	Общий
2,3,4,5,11, 12,13,14	2,3,4,5,9,10, 11,12,13,14	2,3,4,5,11,12 13,14	2,3,4,5,11 12,13,14	2,3,4,5,11 12,13,14	Вход
6,10	6	6,10	6,7,9,10	6,7	Ненивертирующие выходы
7,9	7	7,9	-	9,10	Инвертирующие выходы
8	8	8	8	8	Питание

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	1-2000
амплитуда ускорения, $m/s^2$ (g)	200 (20)
Механический удар одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, $m/s^2$ (g)	1500 (450)
длительность действия ударного ускорения, мс	0,1-2,0
Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $m/s^2$ (g)	1500 (450)
длительность действия ударного ускорения, мс	1-5
Линейное ускорение, $m/s^2$ (g)	5000 (500)
Повышенная рабочая температура среды, К	343
Пониженная рабочая температура среды, К	228
Изменения температуры среды, К	от 213 до 343
Повышенная относительная влажность при температуре 308 К без конденсации влаги, %	98
Атмосферное пониженное давление, Ра	26664
Атмосферное повышенное давление, Ра	294199

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 3.1. Электрические параметры (при температуре 298±10 К)

Наименование параметра	Н О Р М А	Примечание
1. Выходное напряжение высокого уровня, V, не менее	-9,5	1
2. Выходное напряжение низкого уровня, V, не более	-1,0	2
3. Ток потребления микросхем типов К172ИМ1, К172ИМ1, К172ИР1, мА	0,4 не более 2,5	3
4. Ток потребления микросхем К172ИБ2, мА	0,2 не более 1,5	
5. Ток потребления микросхемы К172ИМ1, мА	0,8 не более 5,0	
6. Входной ток высокого уровня, мА,	не более 1,3	4

П р и м е ч а н и я : 1. При пороговом напряжении низкого уровня минус 2,0V; пороговом напряжении высокого уровня минус 8,5V; максимальном напряжении высокого уровня минус 20,0V; напряжении питания минус 24,3V; сопротивлении нагрузки 1MΩ.

2. При пороговом напряжении низкого уровня минус 2,0V; пороговом напряжении высокого уровня минус 12,0V; максимальном напряжении высокого уровня минус 20,0V; напряжении питания минус 29,7V; без подключения нагрузки.

3. При пороговом напряжении высокого уровня минус 2,0V; максимальном напряжении высокого уровня минус 20,0V; напряжении питания минус 29,7V.

4. При пороговом напряжении низкого уровня и напряжении питания равном нулю; максимальном напряжении высокого уровня минус 20,0V.

### 3.2. Пределы-допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра	З о р м а
1. Напряжение питания, V	-29,7
2. Максимальное выходное напряжение, V	-18,0

## 4. УКАЗЕНИЯ ПО ГРУЖЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

4.1. Микросхемы должны применяться и эксплуатироваться в соответствии с разделом 5 ГОСТ 18725-83, учитывая дополнения и уточнения, изложенные в настоящем разделе.

4.2. При эксплуатации микросхем необходимо принимать меры защиты их от воздействия статического

электричества. Допустимое значение статического потенциала не более 30 в.

4.3. Для пайки рекомендуется применять припой ХПОССу 61-05 и флюс ФСв.

Групповая пайка при температуре не выше 538 К, продолжительность пайки не более 4 с.

4.4. Монтаж и демонтаж микросхем необходимо производить при отключенных источниках питания.

4.5. Установку и изъятие микросхем из контактных приспособлений необходимо производить при отсутствии контактирующих напряжений на выводах контактного устройства.

4.6. Немодифицированные входы микросхем должны быть заземлены.

## 5. ХРАНЕНИЕ

Микросхемы следует хранить в стабилизированных (или охлаждаемых) и вентилируемых складах при температуре от 278 до 313 К и относительной влажности воздуха до 80%. При температуре 298 К и при более низких температурах без конденсации льда.

При более высоких температурах относительная влажность ниже.

Микросхемы соответствуют технологическим условиям.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИМКЕ

Микросхемы К172ИМ1, К172ИМ2, К172ИМ, К172ИК1, К172ТР1 прошли ~~оценку~~ технологическую проверку и правильны для использования.

